CURRICULUM VITAE



KHALDI OTHMEN

Maître de Conférences en physique

Contact

Portable: +21622379238

Courriel:othmen.khaldi@gmail.com

- Responsabilités -

- Directeur du département de physique à la faculté des sciences de Gafsa pour les périodes 2017-2020 et 2020-2024.
- Coordinateur de mastère professionnel en Ingénierie et gestion de l'énergie (Formation à distance) durant l'année universitaire 2016-2017.
- Membre du conseil scientifique à la faculté des sciences de Gafsa 2017-2024 et 2024-2027.
- Membre de Jury de la commission des bourses pour des études de mastère et doctorat à l'étranger (2018-2019 et 2019-2020).
- Membre de la commission de sélection des candidats de mastère de recherche en physique à la faculté des sciences de Gafsa (2016-2025).
- Membre de Jury de la commission de sélection des assistants contractuels à l'université de Gafsa (2018-2025).
- Membre de jury d'évaluations des projets de fin d'études des étudiants de la licence appliquée en physique (depuis 2014).
- Rapporteur pour les étudiants de mastère de recherche en physique à la faculté des sciences de Gafsa (depuis 2016).
- Coordinateur des Travaux Pratiques au département de physique (2014-2016).

- Responsable de la préparation des dossiers d'habilitation des parcours
 Licence unifié en physique, physique-énergie et génie énergétique pour la période 2020-2024.
- Membre de l'équipe qui a préparé le dossier PAQ-DGSU accordé en 2019 à l'université de Gafsa.
- Referee dans: Journal of Material Science et Thin films, Applied Surfaces.
- Membre de l'association nationale de la réforme de l'enseignement secondaire 2018-2020.
- Organisation des manifestations scientifiques: Membre du comité d'organisation du congrès international sur les matériaux et l'énergie, CIMATEN2021, Sousse-Tunisie 2021.

Liste des articles

A- Articles

- [A1] O. Khaldi, P. Gonon, C. Mannequin, C. Vallée, F. Jomni and A. Sylvestre,
 "Change in admittance of HfO2 Metal-Insulator-Metal (MIM) capacitors after
 dc bias stress", ECS Solid State Letters, 2 (5) N15-N17 (2013).
- [A2] **O. Khaldi**, F. Jomni, P. Gonon, C. Mannequin and B. Yangui, "Investigation of electrical properties of HfO2 Metal-Insulator-Metal (MIM) devices", App. Phys. A: Materials Science & Processing, DOI 10.1007/s00339-014-8292-8 (2014).
- [A₃] O. Khaldi, F. Jomni, P. Gonon, C. Vallée, C. Mannequin and B. Yangui, "Experimental evaluation of the forming process of virgin HfO₂cells by capacitance-voltage-measurements ", Physica Status Solidi (RRL) - Rapid Research Letters 1–5, DOI 10.1002/pssr.201409153 (2014).
- [A4] O. Khaldi, P. Gonon, C. Vallée, C. Mannequin, K. Malek, A. Sylvestre and F. Jomni, "Differences between dc and ac capacitance nonlinearities in high-k dielectrics and their relation to hopping conduction" Journal of Applied Physics 116(8):084104-084104-8 (2014).
- [A5] A.Selmi, **O.Khaldi** et al. "Dielectric relaxations in Bao.85Sro.15TiO3 thin films deposited on Pt/Ti/SiO2/Si substrates by sol–gel method", Journal of

- Materials Science Materials in Electronics, 27(11) 11299–11307 (2016).
- [A6] M.Kassmi, F.Jomni, P.Gonon, O.Khaldi, et al. "Reliability of HfO2 metal-insulator-metal capacitors under AC stress", Journal of Physics D Applied Physics, 49(16):165502 (2016).
- [A7]O. Khaldi, F. Jomni, P. Gonon, "Correlations between first principle calculations and electrical properties of HfO2:Al2O3 alloys for MIM capacitors applications" Journal of Applied Physics 128, 134101 (2020).
- [A8]O. Khaldi, F. Jomni, P. Gonon and C. Vallée, "AC and DC bias effect on capacitance voltage nonlinearities in Au/HfO2/M MIM capacitors; Journal of Materials Science: Materials in Electronics, 31, 19036 (2020).
- [A9]O. Khaldi, T. Arbi, A. Majouri, "Theoretical and experimental investigation of the electronic, optical and mechanical properties of Zn doped anatase TiO₂ for photocatalytic applications", Applied Physics A 127, 557 (2021).
- [A10] A. Selmi, **O. Khaldi** et al., "Screen-printed ferroelectric Ba_{0.85}Sr_{0.15}TiO₃ thick films for miniaturized tunable devices", Journal of Alloys and Compounds 878, 160340 (2021).
- [A11] O. Khaldi, and F. Jomni, "Understanding the physical origin of negative capacitance (NC) in High-k oxides: Experimental and ab-initio approach",
 Chemical Physics Letters 781, 138964 (2021)
- [A12] O. Khaldi, H. Ferhi, T. Larbi and F. Jomni, "Dielectric response of high-k Hafnium oxide under finite field: nonlinearities from ab-initio and experimental point of views", Phys. Chem. Chem. Phys., 25, 22310-22318 (2023).
- [A13] H. Saadi, O. Khaldi, T. Larbi and Z. Benzarti, "Correlations between structural, dielectric properties, and ab initio calculations in Co-doped ZnO nanoparticles: effect of Co concentration", Applied Physics A 129, 12 (2023).
- [A14] H. Saadi, O. Khaldi, J. Pina, T. Costa, J. S. de Melo, P. Vilarinho and Z.
 Benzarti "Effect of Co Doping on the Physical Properties and Organic
 Pollutant Photodegradation Efficiency of ZnO Nanoparticles for
 Environmental Applications", Nanomaterials, 14, 122 (2024).

- [A15] O. Khaldi, Y. Zidi, "Impact of the Al-Cu alloys on the electronic, optical and elastic properties of X_{O2} oxides (X=Zr, Hf)", Journal of Optics, https://doi.org/10.1016/j.ijleo.2024.171729 (2024).
 - [A16] O. Khaldi, M. Zemzemi, H. Ferhi and F. Jomni, "Relationship Between Electrode Material, Valence Band Offset, and Nonlinearity in the Resistive Switching Behavior of Au/HfO2/M (M = TiN, W, Pt, or AlCu) Metal–Insulator–Metal Devices: Correlation Between Experimental and DFT Calculations", Journal of Electronic Materials, 53, 4357, 2024.
 - [A17] K Nehdi, T Larbi, **O Khaldi**, K Doll, M Amlouk, "DFT investigation on the design and optimization of icosahedral and octahedral beryllium nitride (Be₃N₂) x fullerene analogue. A comparative study with isosymmetry carbon fullerene", Chemical Physics, 586, 112398 (2024).
 - [A18] H. Saadi, O. Khaldi, J. Pina, T. Costa, J. S. de Melo, P. Vilarinho and Z. Benzarti "Influence of (Co+ Al) co- doping on structural, microstructural, optical and electrical properties of nanostructured zinc oxide", Ceramics International, 50 (21), 44151 (2024).
 - [A19] Y. Zidi, O., Khaldi,, R.E., Patru, Roxana Elena, R., Ben Younes, A.C., Galca, Aurelian Catalin, "Experimental and theoretical perspective on band gap modulation in Sr²⁺ modified BaTiO₃ capacitors", Ceramics International (2025). DOI:https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2025.01.591.
 - [A20] I., Soli., M., Zemzemi, B., Agoubi, B., O., Khaldi, O., K. Kamel, "Computational Modeling of Electronic, Valence Band Offset, and Thermoelectric Transport Properties of SrTiO₃/LaCrO₃ Heterostructures, Journal of Electronic Materials (2024).

B- Liste des communications

- [B1]O. Khaldi, "Effect of bottom Electrode Material on the electrical properties of ALD-deposited HfO₂ in Metal Insulator Metal capacitors",
 Conférence Franco-maghrébine sur les Nanomatériaux. 2 -5 mai 2013 Sousse, Tunisia.
- [B2]O. Khaldi, "Investigation of Dielectric relaxation by Impedance Spectroscopy (IS) and Thermally Stimulated Currents (TSCs) in HfO₂ metal

- insulator metal devices", First International Conference On Innovative Materials and Techniques CIMT 2012, November 12-15, 2012 Hammamet, Tunisia.
- [B₃]O. Khaldi, "Capacitance-Voltage Nonlinearity of Metal-Insulator-Metal Capacitors under DC and AC bias", Troisièmes Journées des Jeunes chercheurs en Physique (3ème JJC), 10-11 Avril 2013, Bizerte, Tunisie.
- [B4]O. Khaldi, " Etude des propriétés électriques des capacités Métal/Isolant/Métal Au/HfO2/TiN", Le 10ème CNRP, 20-23 Décembre 2011. Sousse, Tunisie.
- [B5]O.Khaldi, "Etude des propriétés électriques des capacités Métal/Isolant/Métal Au/HfO2/TiN", Journées des Jeunes chercheurs en Physique, 4 Mai 2012, Faculté des Sciences de Tunis, Tunisie.
- [B6]O. Khaldi, F. Jomni, H. Ouajji, K. Raouadi ,B.Yangui, "Theoretical Analysis of the nonlinear behaviour of high-k MIM capacitors", IMMEA 2009, 2th International Meeting On Materials For Electronic Applications, Hammamet, 8-10 Mai 2009- Tunisia.
- [B7]O. Khaldi, F. El Kamel, P. Gonon, F. Jomni and B. Yangui, "Dielectric response of Au/HfO2/TiN capacitors" Mediterranean Meeting on Functionalized Materials, EMM-FM 2011 September 06-10, Sousse, TUNISIE.
- [B8]O. Khaldi, F. Jomni, P. Gonon et B. Yangui, "Effect of bias stress on the capacitance voltage variations of HfO2 Metal Insulator Metal capacitors" Fourth International Meeting On Dielectric Materials (IMDM'4), Marrakech, May 29-31, 2013, Morocco.
- [B9] M. Kassmi, F. Jomni, O. Khaldi, P. Gonon et B. Yangui, "Etude des processus de relaxation dans le Titanate d'Hafnium (HfO2) par la technique des courants thermo-stimulés, EMM-FM 2011 Septembre 06-10, Sousse, Tunisia.
- [B10] A. SELMI, O. Khaldi, M. MASCOT, F. JOMNI, J. C. CARRU et B. YANGUI, "Investigation of electrical properties of Ba_{0.85}Sr_{0.15}TiO₃ thin films deposited on Pt/Ti/SiO₂/Si substrates "international meeting of advanced materials (MAM)– Hammamet (Tunisie) o6-o9 septembrer, 2015.

- [B11] A. SELMI, O. Khaldi, M. MASCOT, F. JOMNI and J. C. CARRU, "Study of the electrical properties of Bao.85Sro.15TiO3 thick layers prepared by screen printing method on Ag-Pd / Al2O3 substrates", Third Francophone Meeting on Insulating Materials Mahdia, 28 30 October 2016.
- [B12] O. Khaldi, "Theoretical analysis of the electronic and optical properties of metal oxides by DFT theory", International Conference on Innovative Materials, Monastir, October 2019.
- [B13] O. Khaldi, "Ab-initio calculations for the electronic, optical and mechanical properties of Zn doped anatase TiO₂", Les Journées de Recherche en Sciences et Technologie (JouRSeT2020), FS-Gafsa 25-26 Décembre 2020.
- [B14] A. Majouri, O. Khaldi, "Effet de la pression sur les propriétés électroniques et optiques et magnétiques de ferrites spinelles", les Journées de Recherche en Sciences et Technologie (JouRSeT2020), FS-Gafsa 25-26 Décembre 2020.
- [B15] Y. Zidi, O. Khaldi, "Electronic, optical and thermodynamic properties of BaSrTiO₃ films based on the DFT approach", CIMATEN 2021, Sousse, Tunisia.
- [B16] O. Khaldi, "Ab initio study of the high frequency dielectric response of metal oxide materials by Coupled Perturbed Hartree Fock/Kohn-Sham and Finite Electric field Perturbation methods", 5th International Conference on Smart Materials and Spectroscopy SMS 2022, Sousse, Tunisia.
- [B17] O. Khaldi, "Physical Origin of negative capacitance in high k oxides for ReRAM devices applications", International Conference on Innovative Materials Manufacturing and Advanced Technologies IMMAT 2022, Sousse, Tunisia.
- [B18] O. Khaldi, "Methods to identify Phase transition in perovskite materials: abinitio and experimental point of views", International Conference on on Smart Materials and Spectroscopy SMS 05-07-2023, Monastir, Tunisia.

—Stages et Formation —

- Date: du 20/08/2011 au 19/09/2011.

Objectif: Etude des propriétés électriques des matériaux High k (HfO₂).

Lieu : Laboratoire de Génie Electrique de Grenoble (G2ELab-CNRS).

- **Date**: du 01/06/2012 au 31/07/2012.

Objectif: Etude du phénomène de non-linéarité en tension des capacités MIM à base de HfO₂.

Lieu : Laboratoire des Technologies de la Microélectronique (LTM) au CEA-Leti de Grenoble.

- Date: du 22/08/2012 au 15/01/2013.

Objectif: Etude des mécanismes de dégradation du comportement électrique des capacités MIM à base de HfO₂.

Lieu : Laboratoire des Technologies de la Microélectronique (LTM) au CEA-Leti de Grenoble.

Formation: « Localisation des charges électriques dans les isolants », RFMI 2016

Formation : « Formation de formateurs aux technologies de l'infos », AUF 2016.

—Coopérations nationales et internationales

- **Prof.** Patrice Gonon : Université de Joseph-Fourier, Laboratoire des technologies de la Microélectronique (LTM), CEA-Leti-Grenoble, France.
- Prof. Christophe Vallée : Université de Joseph-Fourier, Laboratoire des technologies de la Microélectronique (LTM), et STM Microélectronique, Grenoble, France.
- Prof. Jean Claude Carru: Laboratoire UDSMM, Université du Littorale-Côte d'Opale, Calais-France.
- Prof. Rached Ben Younes: Université de Gafsa, Laboratoire UPIM, Gafsa,
 Tunisie.
- **Dr. Tarek Larbi**: Université de Tunis El Manar, Unité de physique des dispositifs a semi-conducteurs, Faculté des sciences de Tunis, Tunisie.
- Dr. Zohra Benzarti: Université de Sfax, Laboratoire des Matériaux Multifonctionnelles et Applications (LaMMA), Faculté des Sciences de Sfax, Tunisie.

—Compétences et langues-

Domaines de compétences scientifiques

- Etude des propriétés diélectriques des matériaux
- Etude des propriétés électriques des matériaux
- Etude des mécanismes de dégradation dans les oxydes
- Calcul ab-initio, propriétés physiques des matériaux

Domaines de compétences informatiques

- Système d'exploitation : Linux, Live OS, windows...
- Languages de programmation : Java, C, C++, Matlab, Shell script, Fortran
- Systèmes de gestion de bases de données :
- Bureautique : Open Office, Microsoft Office (2000...2007), Latex.

Langues

- Anglais : lu, écrit, parlé (Formation TOEIC en 2019).
- Français : lu, écrit, parlé
- Arabe : langue maternelle